
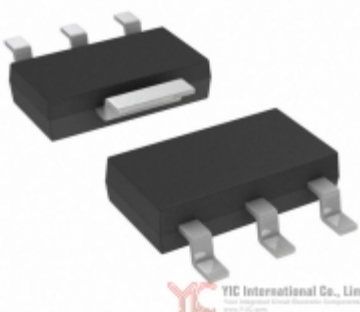
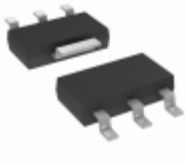
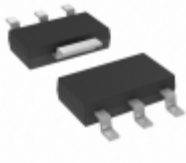



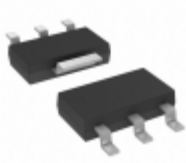

	<h2 style="color: red;">FDT86246L</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FDT86246L</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDT86246L.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 22538 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDT86246L
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	22538 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223-4
Verlustleistung (max)	1W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	228 mOhm @ 2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.3nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	335pF @ 75V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FDT86246L ist neu im Original, Suche FDT86246L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDT86246L Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FDT86246L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDT86244 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2.8A SOT-223</p>	 <p>FDT86244 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2.8A SOT-223</p>	 <p>FDT86256 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 1.2A SOT-223-4</p>	 <p>FDT86256 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 1.2A SOT-223-4</p>
 <p>FDTC-08M-E-00N-00N-A 3M FIBER DOME TERMINAL CLOSURES</p>	 <p>FDT86113LZ Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.3A SOT223</p>	 <p>FDT86246L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223</p>	 <p>FDT86246 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ 06033C562KAT2A	↔ A5949GETTR-T	⇒ APT30D120BG	D AS1909C-168-T	⇒ BD5343FVE
⊖ BR93A66RF-WE2	⊕ BXA60-5094-TL1	D C1005C0G1H390J050BA	⇒ CD4001BCN	⇒ CLC3605ISO16X
⊕ D801S45T	⊖ EMK212B7334KG-T	⊕ ES1C-M3/61T	↔ FDT1600N10ALZ	⇒ FDT1600N10ALZ
D FDT3N40TF	⊕ FDT3N40TF	⊖ FDT434P-NL	⊕ FDT439N-NL	⇒ FDT458P-NL
⇒ FDT55AN06LA0	↔ FDT55AN06LA0	⊕ FDT86102LZ	⊖ FDT86102LZ	⇒ FDT86106LZ
↔ FDT86106LZ	⇒ FDT86113LZ	D FDT86113LZ	⊕ FDT86244	⊖ FDT86244
⊕ FDT86246	D FDT86246	⇒ FDT86246L	↔ FDT86256	⇒ FDT86256
⊖ GRM0337U1E560JD01D	⊕ ISL6292-2CR3Z-T	↔ LD03ZC154KAB2A	⇒ LES30A48-3V3EJ	⇒ MMSZ5256B-13-F
⊕ QM200HA-HE	⊖ QM3014M6	⊕ R2033T-E2-F	D RF3189SR	⇒ SI3008-B-FS
↔ TPS79625KTTTG3	⊕ TSL0808RA-2R2M3R9-PF	⊖ V300A5C400AN	⊕ WDH121212H-1W	⇒ ZLNB254DEETA

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited